

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2014-512899

(P2014-512899A)

(43) 公表日 平成26年5月29日 (2014.5.29)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 8/00 (2006.01)	A 6 1 B 8/00	4 C 6 0 1
H 0 4 R 17/00 (2006.01)	H 0 4 R 17/00 3 3 0 J	5 D 0 1 9

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 12 頁)

(21) 出願番号	特願2013-558556 (P2013-558556)	(71) 出願人	590000248
(86) (22) 出願日	平成24年3月14日 (2012.3.14)		コーニンクレッカ フィリップス エヌ
(85) 翻訳文提出日	平成25年9月6日 (2013.9.6)		ヴェ
(86) 国際出願番号	PCT/IB2012/051208		オランダ国 5 6 5 6 アーエー アイン
(87) 国際公開番号	W02012/123908		ドーフエン ハイテック キャンパス 5
(87) 国際公開日	平成24年9月20日 (2012.9.20)	(74) 代理人	100087789
(31) 優先権主張番号	61/453,690		弁理士 津軽 進
(32) 優先日	平成23年3月17日 (2011.3.17)	(74) 代理人	100122769
(33) 優先権主張国	米国 (US)		弁理士 笛田 秀仙
		(74) 代理人	100163809
			弁理士 五十嵐 貴裕
		(72) 発明者	スドル ヴォイテク
			オランダ国 5 6 5 6 アーエー アイン
			ドーフエン ハイ テック キャンパス
			ビルディング 4 4

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 超音波トランスデューサアレイに対する高い熱伝導性を持つ高多孔性音響支持体

(57) 【要約】

超音波プローブの超音波トランスデューサアレイ・スタックに関する支持ブロックが、エポキシ樹脂で含浸される黒鉛発泡の複合構造として形成される。エポキシ樹脂は、黒鉛発泡ブロックの少なくともある程度の深度まで多孔質発泡構造に浸透し、硬化されるとき、良い構造安定性を支持ブロックに提供する。複合黒鉛発泡支持ブロックは、トランスデューサの集積回路に結合され、トランスデューサから離れて高い熱伝導性を提供し、後部音響反響の良好な音響減衰又は散乱を提供する。

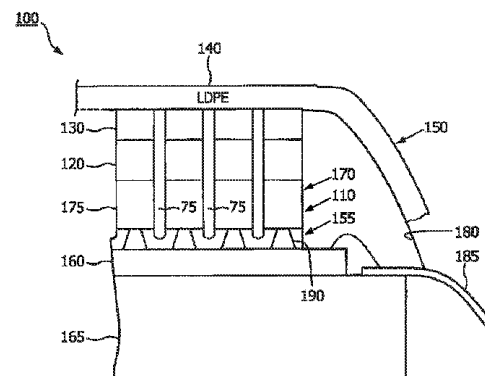


FIG. 1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

超音波トランスデューサアレイアセンブリであって、
超音波の送信に関する望ましい前方方向と、望ましくない後方の超音波放出方向とを持つトランスデューサ要素のアレイと、
前記トランスデューサ要素のアレイに構造的に結合される集積回路と、
前記トランスデューサ要素のアレイ及び集積回路の後方に配置される複合発泡支持ブロックであって、多孔質構造体を持つ発泡物質で形成される、複合発泡支持ブロックと、
前記発泡支持ブロックの多孔質構造の少なくともいくつかを充填するエポキシ樹脂とを有し、

10

前記後方方向における超音波放出が、前記多孔質発泡構造及びエポキシにより散乱又は減衰され、熱は、前記支持ブロック物質により前記トランスデューサ要素のアレイ及び集積回路から離れて伝導される、超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【請求項 2】

前記発泡物質が更に、黒鉛発泡を有する、請求項 1 に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【請求項 3】

前記複合発泡支持ブロックが更に、外側表面を有し、前記エポキシ樹脂は、前記外側表面に隣接する前記発泡支持ブロックの前記多孔質構造を充填する、請求項 1 に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

20

【請求項 4】

前記集積回路が更に、前記トランスデューサ要素のアレイの前記後部側面に結合されるビーム形成器 A S I C を有し、前記複合発泡支持ブロックは、前記ビーム形成器 A S I C に熱的に結合される、請求項 1 に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【請求項 5】

前記複合発泡支持ブロックが、エポキシ結合により前記ビーム形成器 A S I C に結合される、請求項 4 に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【請求項 6】

前記ビーム形成器 A S I C 及び前記複合発泡支持ブロックの間の電気絶縁層を更に有する、請求項 4 に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

30

【請求項 7】

前記電気絶縁層が更に、ポリイミドフィルムを有する、請求項 6 に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【請求項 8】

前記ポリイミドフィルムが、25 ミクロンより厚くない、請求項 7 に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【請求項 9】

前記電気絶縁層が更に、バリレン被覆を有する、請求項 6 に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【請求項 10】

前記バリレン被覆が、15 ミクロンより厚くない、請求項 9 に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

40

【請求項 11】

前記多孔質構造体が、少なくとも 60 % の多孔性を示す、請求項 1 に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【請求項 12】

前記多孔質構造体の総孔の少なくとも 95 % が、オープンである、請求項 11 に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【請求項 13】

エポキシ、前記多孔性発泡物質及び前記多孔質発泡構造における空気の間の前記インピ

50

ーダンス不整合が原因で、前記後部超音波放出が、散乱する、請求項1に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【請求項14】

前記多孔性発泡物質が更に、黒鉛発泡物質を有する、請求項13に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【請求項15】

前記エポキシ樹脂による吸収が原因で、後部超音波放出が減衰される、請求項1に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

10

【0001】

本発明は、医療診断超音波システムに関し、より詳細には、超音波トランスデューサアレイに関する支持体物質に関する。

【背景技術】

【0002】

2次元アレイトランスデューサは、3次元においてスキャンを行う超音波撮像において用いられる。2次元アレイは、方位角及び上昇方向の両方においてトランスデューサ要素の多数の行及び列を持つ。これは、プローブ及びメインフレーム超音波システムの間の信号を結合する大きな数のケーブル導体を必要とする。プローブケーブルにおける信号導体の数を最小化するための好ましい技術は、マイクロビーム形成器ASIC（特定用途集積回路）においてプローブにおけるビーム形成の少なくともいくつかを実行することである。この技術は、比較的少数の部分的にビーム形成された信号が、メインフレーム超音波システムに結合されることだけを必要とし、これにより、ケーブルにおいて必要とされる信号導体の数が減らされる。しかしながら、多数の信号接続が、2次元アレイ及びマイクロビーム形成器ASICの間で作られなければならない。これらの接続を作る効率的な態様は、フリップチップ相互接続を持つようトランスデューサアレイ及びASICを設計することである。これにより、トランスデューサアレイの導電性パッドが、ASICの対応する導電性パッドに対して直接バンプボンディングされる。

20

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

30

【0003】

しかしながら、マイクロビーム形成器ASICの高密度電子回路は、その小さなICパッケージにおいてかなりの量の熱を生成する可能性がある。この熱は、発散されなければならない。この熱が流れることができる2つの主方向が存在する。1つの方向は、プローブの患者接触端部でレンズの方へ音響スタックをフォワードスルーするものである。熱伝導性は、トランスデューサスタックにおける電氣的導電要素によりこの方向において支援される。このフォワード経路は、熱フローに対して相対的に低い抵抗を示す。レンズにおける熱の集積は、送電電圧及び／又はパルス反復周波数を減らすことにより防止されなければならない。これは、プローブ性能に悪影響を与える。

【0004】

40

好ましい熱伝導方向は、後部に向かう、レンズから離れる、及びプローブの背後のヒートスプレッド（通常はアルミニウム）に向かうものである。しかし一般にトランスデューサスタック、アレイ要素及びマイクロビーム形成器ASICの後ろに配置されるのは、音響支持ブロックである。音響支持ブロックの目的は、音響スタックの後部から放射する超音波エネルギーを減衰させ、及びこのエネルギーが音響スタックの方へ反射される反射を引き起こすのを防止することである。音響支持ブロックは一般に、例えばマイクロバルーン又は他の防音材粒子が載せられたエポキシといった良好な音響減衰特性を持つ物質でできている。プローブアセンブリの支持構造体（通常アルミニウム）からASICを分離するために多くのエポキシ充填複合支持体が開発されたが、それらは2つの不利な点を持つ。高い減衰を持つよう作成される場合、それらは許容できない熱コンダクタンスを持つ。

50

高い熱コンダクタンスを持つよう作成される場合、それらは許容できない減衰を持つ。従って、ブロックに入る音響エネルギーの良好な音響減衰を示し、プローブの後部に向かって及びレンズから離れて良好な熱伝導性を示し、必要に応じて音響スタックを支持することができる良い構造安定性を示し、プローブの他の導電性要素からマイクロビーム形成器 A S I C の適切な電気絶縁性を示す、超音波プローブに関する音響支持ブロックを提供することが望ましい。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明の原理によれば、超音波トランスデューサアレイ・スタックに関する支持ブロックは、高い音響減衰及び高い熱伝導性を持つ多孔性黒鉛発泡物質で形成される。好ましい実現において、発泡支持ブロックは、エポキシ樹脂で充填される発泡構造を持つ複合物として構築される。電氣的単離層は、支持ブロックの上部に配置されることができ、支持ブロック及び音響スタックアセンブリの A S I C の間が結合される。

【図面の簡単な説明】

【0006】

【図1】本発明の原理に基づき構築される熱伝導支持ブロックを持つ音響スタックを示す図である。

【図2】レンズカバーを持つトランスデューサプローブにおいて組立てられるときの図1の音響スタックを示す図である。

【図3】本発明の原理に基づき構築される熱伝導支持ブロックの透視図である。

【図4】本発明の原理に基づき構築される熱伝導支持ブロックの平面図である。

【図5】本発明の原理に基づき構築される熱伝導支持ブロックの側面断面図である。

【図6】本発明の原理に基づき構築される複合発泡支持ブロックを示す図である。

【図7】A S I C 及び複合発泡支持ブロックの間のフィルム絶縁層を持つ本発明の音響スタックアセンブリを示す図である。

【図8】バリレン被覆された複合発泡支持ブロックを持つ本発明の音響スタックアセンブリを示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0007】

図1を最初に参照すると、本発明の原理に基づき構築される熱伝導支持ブロックを持つ音響スタック100が、概略的に示される。P Z T といった圧電層110及びこの圧電層に結合される2つの整合層が、個別のトランスデューサ要素175のアレイ170を形成するためにダイシングカット75によりダイシングされる。これのうちの4つが、図1に見られる。アレイ170は、単一の行のトランスデューサ要素(1-Dアレイ)を有することができるか、又はトランスデューサ要素の2次元(2-D)行列アレイを形成するため、2つの直交する方向においてダイシングされることができる。整合層は、一般に累進的な整合層のステップにおいて、診断される体の音響インピーダンスに圧電材料の音響インピーダンスを整合させる。この例において、第1の整合層120は、電気導電黒鉛複合体として形成され、第2の整合層130は、電気導電粒子が載せられたポリマーで形成される。接地平面180は、第2の整合層の上部に結合され、及び低密度ポリエチレン(L D P E)140の膜150上に導電層として形成される。接地平面は、電気導電整合層を通りトランスデューサ要素に電氣的に結合され、フレックス回路185のグラウンド導電体に接続される。L D P E 膜150は、スタックの3番目及び最終的な整合層140を形成する。

【0008】

トランスデューサ要素の下には、集積回路160であるA S I C が存在する。これは、トランスデューサ要素175に関する送信信号を提供し、この要素から信号を受信しこれを処理する。集積回路160の上部表面にある導電性パッドは、スタッドバンプ190によりトランスデューサ要素の底部にある導電性パッドに電氣的に結合される。これは、はんだ又は導電性エポキシで形成されることができる。信号は、フレックス回路185への

接続により集積回路 160 へ／から提供される。集積回路 160 の下に、トランスデューサスタックの底部から放射する音響エネルギーを減衰させる支持ブロック 165 がある。本発明の原理によれば、この支持ブロックも、集積回路及びトランスデューサスタックから離れて、及びトランスデューサプローブの患者接触端部から離れて、集積回路により生成される熱を伝導する。

【0009】

図 2 は、トランスデューサプローブ内部で組立てられるときの図 1 のトランスデューサスタック・アセンブリを示す。図 2 のプローブにおいて、第 3 の整合層 140 は、音響レンズ 230 に結合される。超音波は、レンズ 230 を通り、撮像の間、患者の体へと送信され、これらの波に対して受信されるエコーは、レンズ 230 を通りトランスデューサスタックにより受信される。LDPE 膜 150 は、本実施形態においてトランスデューサスタックを囲むよう機能する。なぜなら、それがスタック周りで包まれ、エポキシボンディング 210 によりプローブ筐体 220 に結合されるからである。この構造の追加的な詳細は、米国特許出願公開第 2010/0168581 号 (Knowles その他) において見つけ出される。

【0010】

支持ブロック 165 に関する好ましい実現が、残りの図面に示される。好ましい支持ブロック 165 は、黒鉛 20 のブロックで始まる。他の代替案は、例えば良い機械処理適性及び好ましい熱特性を提供するニッケル又は銅といった金属が載せられた黒鉛を含む。黒鉛ブロック 20 が、複数の性能目的を満たす複合支持構造体を形成するために用いられる。第 1 に、支持構造体は、良好な Z 軸熱伝導性を持たなければならない。黒鉛は、良好な熱伝導性を持ち、 T_c は、 $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ で $80 \sim 240$

$$\text{W/m}^{\circ}\text{K}$$

である。結晶層に平行な伝導に関して、 T_c は、 300

$$^{\circ}\text{K}$$

で 1950

$$\text{W/m}^{\circ}\text{K}$$

に接近するであろう。Z 軸方向は、トランスデューサスタック 100 及び集積回路 160 の背後の方向で、これらから離れる方向である。こうして、Z 軸方向における熱フローに関して黒鉛ブロック 20 の結晶層を整列配置することが望ましい。他の実現において、横方向に、又は、横方向及び Z 軸方向の両方において、好ましく熱を伝導することが望ましい場合がある。この場合、異なる方向の水晶整列が望まれるか、又は整列方向が設計にとって重要でなくなる場合がある。熱の一部を発散させるためにアルミニウムが用いられるとき（これは、プローブ筐体内部のアルミニウムヒートスプレッダ又はアルミニウムフレームを用いて行われることができる）、支持ブロックの熱伝導性が、アルミニウムの熱伝導性に匹敵するか又はこれより良好であることが望ましい。その結果、熱は、好ましい態様でアルミニウムに流れる。アルミニウムは、室温で、 237

$$\text{W/m}^{\circ}\text{K}$$

に匹敵する T_c を持つ。そこで、この性能目標は、黒鉛ブロック 20 により十分満たされる。

【0011】

第 2 の目的は、支持ブロックが、音響スタック 100 及び集積回路 160 に関する構造

的支持体を提供するということである。黒鉛ブロックは、構造的に頑丈である。従って、この目的が達成される。

【0012】

第3の目的は、プローブのアルミニウム部材又はフレームから集積回路160の電気絶縁を提供することである。黒鉛は、電気導電であり、非導電性絶縁被覆で支持ブロックを被覆することにより、この目的を満たすことができる。いくつかの実現において、トランスデューサスタックと接触するブロックの側面だけを被覆することが望ましい場合がある。他の実現において、支持ブロックの複数の側面を被覆することが望ましい場合がある。例えば、横方向の音響反響を抑制する追加的な利益を提供する絶縁音響減衰物質でブロックの横方向の側面を被覆することが望ましい場合がある。

10

【0013】

第4の目的は、支持ブロックが、ブロックに入る音響エネルギーを緩衝させなければならないということである。黒鉛は、音響エネルギーの良好な導体であり、ごくわずかな固有の音響減衰しか提供しない。この目的は、図3、4及び5に示されるように、内部音響緩衝部材の複合構造に関する枠組みとして黒鉛ブロックを使用することにより満たされる。これらの図面において、黒鉛は、ブロックの内部複合構造の説明の明確さのため半透明にレンダリングされる。緩衝部材は、支持ブロックにおける支持体物質の複数の角度をつけられたシリンダー30として形成される。シリンダー30は、黒鉛ブロック20へと切断又は穿設され、その後、例えばマイクロバルーン又は他の音響減衰粒子で充填されたエポキシといった音響緩衝物質で充填される。図4の支持ブロックの平面図が示すように、シリンダー30の上部は、集積回路の背部に対して音響緩衝物質の大きな領域を提供する。こうして、集積回路及び音響スタックの背部から放射する望ましくない相当量の音響エネルギーが、緩衝物質へと直ちに進む。図3に見られるように、及び図5の断面図において最も良く示されるように、シリンダーに角度をつけることは、Z軸方向において進行する音響エネルギーが、進行の経路におけるいくつかのポイントで緩衝物質と交差しなければならないことを確実にする。好ましくは、完全に黒鉛で形成されるZ軸方向における経路は存在しない。シリンダーに角度をつけることは、集積回路に戻るエネルギーの反射を助長せず、集積回路から下方に離れる散乱角度を提供する。実際には、例えば経路の95%をブロックすることにより、大部分のZ軸経路をブロックすれば十分である。こうして、シリンダーに角度をつけることは、Z軸方向のエネルギーの全て又は実質的に全ての減衰を確実にする。

20

30

【0014】

しかしながら、熱は、シリンダー30の間の黒鉛を通る連続的な経路を見つける。熱は、高い温度領域から低い温度領域へと（より大きな熱密度から小さな熱密度へと）流れるので、熱は集積回路160及び音響スタック100から支持ブロック165の下で構造へと流れることになる。支持ブロックにおいて、熱は安全に発散させられることができる。

【0015】

例えばアルミニウム、黒鉛発泡又は窒化アルミニウムといった他の物質が、支持ブロックの熱伝導性物質に関して用いられることができる。多くの用途にとって有利であることが見出される1つの複合構造が、エポキシ樹脂で充填される導電性黒鉛発泡である。上述された機械加工及び充填された黒鉛ブロックの巨視的な性質は、ASICに対する不均等なボンディング表面を提供することができる。これは、拡張ミスマッチに対して弱い。穴を機械加工し、エポキシで充填することは、労働集約的な処理でもある。図6は、本発明の実現を示す。図6の支持ブロックの支持体物質は、柔らかい無充填減衰エポキシ樹脂で充填される熱伝導性黒鉛発泡（POCO-HTC）を用いる。無充填HTC発泡は、かなりの多孔性（60%）を持つ。総孔の95%はオープンである。このオープン孔が柔らかい樹脂で充填されるとき、この複合支持体は、5MHzでおよそ50dB/mmの高い音響減衰を示す。この高い減衰は、主に2つの機構が原因である。それは、1）柔らかい樹脂による音響エネルギーの吸収、及び2）エポキシ、黒鉛及び多孔質構造体における空気の間インピーダンス不整合が原因による音響エネルギー散乱である。この高い音響減衰

40

50

の結果として、支持体厚は、トランスデューサ熱放散を容易にするために減らされることができる。このエポキシ充填された黒鉛発泡の別の特性は、その高い熱伝導性（ $\sim 50 \text{ W/m K}$ ）である。これは、典型的なエポキシ充填材支持構造体より 1 オーダー高い大きさである。

【 0 0 1 6 】

図6の複合黒鉛発泡支持ブロック32は、発泡の高い多孔性を示す。この例において、発泡ブロック32の表面は、図面において陰影のついた領域により示されるように、発泡ブロックの多孔性及び樹脂の粘性の関数である深度36の分、ブロックにしみ込むエポキシ樹脂34で被覆される。硬化されたエポキシは、ブロックに良い構造安定性を与える。複合支持ブロックは、薄いエポキシボンドラインでASIC160に直接結合されることができる。ASICから適切な電気絶縁を提供するため、図7及び図8に示されるように支持ブロック及びASICの間に絶縁層が用いられることができる。これは、音響スタックにおける2つの実現の分解図を示す。各図面の上部には、この整合層を持つトランスデューサ層170がある。トランスデューサ層の下に、ASIC160がある。図7において、支持ブロックをアセンブリに結合する前に、薄い(12~25ミクロン)ポリイミドフィルム38が、ASICに取り付けられる。複合発泡支持ブロック32は、絶縁膜38に結合される。図8において、10~15ミクロンのパリレン被覆58が、HTC支持ブロックに適用される。パリレン被覆された支持ブロックは、ASIC160に結合される。

10

【图 1】

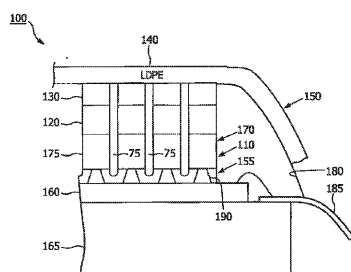


FIG. 1

【图 2】

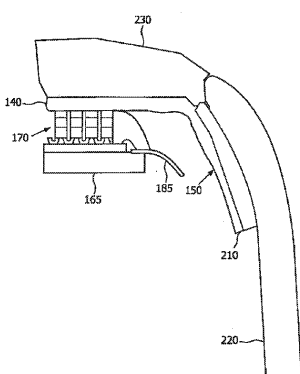


FIG. 2

【图 3】

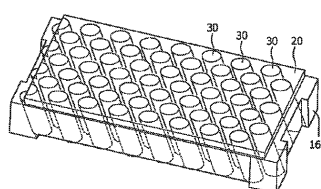


FIG. 3

【圖 4】

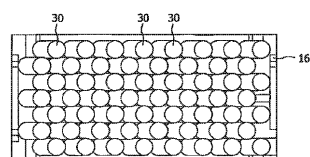


FIG. 4

【图 5】

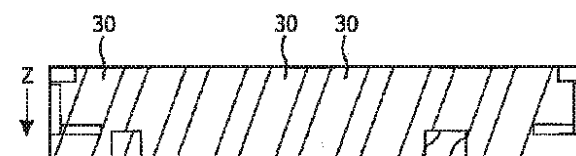


FIG. 5

【図 6】

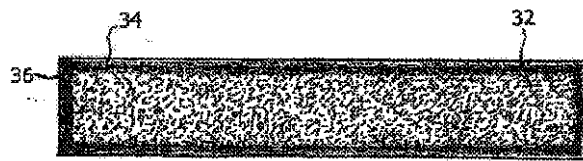


FIG. 6

【図 8】

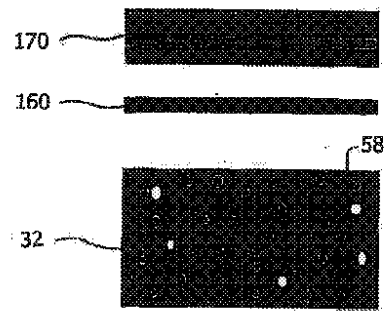


FIG. 8

【図 7】

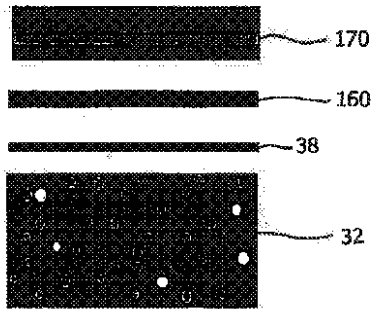


FIG. 7

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/IB2012/051208

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. B06B1/06 G10K11/00 A61B8/00 ADD.		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G10K E04B B60R B64C A61N A61B B06B H04R		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EP0-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 2008/098816 A1 (YAMASHITA YOHACHI [JP] ET AL) 1 May 2008 (2008-05-01) paragraph [0042] - paragraph [0078] figures 2,3	1,3-13, 15
Y	US 2008/315724 A1 (KUNKEL III HAL [US]) 25 December 2008 (2008-12-25) paragraph [0021] figure 2	1,3-13, 15
Y	WO 2008/121238 A2 (GORE ENTERPRISE HOLDINGS INC [US]; OAKLEY CLYDE GERALD [US]; SHEPARD M) 9 October 2008 (2008-10-09) page 17, line 17 - line 18 page 20, line 19 - line 22 page 29, line 8 - line 22	1,3-13, 15
	----- - / - -	
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubt on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
20 February 2013		27/02/2013
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 6818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Breccia, Luca

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/IB2012/051208

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 5 648 941 A (KING ROBERT W [US]) 15 July 1997 (1997-07-15) column 2, line 65 - line 67 -----	15
A	US 6 673 328 B1 (KLETT JAMES W [US] ET AL) 6 January 2004 (2004-01-06) column 17, line 53 - line 64 -----	2
A	JP 2000 165995 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 16 June 2000 (2000-06-16) abstract -----	1
A	US 2009/062656 A1 (HYUGA HIROAKI [JP]) 5 March 2009 (2009-03-05) paragraph [0090] -----	2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/IB2012/051208

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2008098816 A1	01-05-2008	CN 101172044 A JP 4171038 B2 JP 2008118212 A US 2008098816 A1	07-05-2008 22-10-2008 22-05-2008 01-05-2008
US 2008315724 A1	25-12-2008	CN 101237947 A EP 1912748 A2 JP 2009504057 A US 2008315724 A1 WO 2007017780 A2	06-08-2008 23-04-2008 29-01-2009 25-12-2008 15-02-2007
WO 2008121238 A2	09-10-2008	AU 2008233201 A1 CA 2681578 A1 CN 101675468 A EP 2132729 A2 JP 2010527167 A KR 20100003290 A WO 2008121238 A2	09-10-2008 09-10-2008 17-03-2010 16-12-2009 05-08-2010 07-01-2010 09-10-2008
US 5648941 A	15-07-1997	DE 29616806 U1 JP 9127955 A US 5648941 A	28-11-1996 16-05-1997 15-07-1997
US 6673328 B1	06-01-2004	AU 778597 B2 AU 4004801 A CA 2399719 A1 EP 1265825 A2 JP 2003525836 A MX PA02008746 A NZ 520381 A US 6673328 B1 US 2002141932 A1 WO 0166490 A2	09-12-2004 17-09-2001 13-09-2001 18-12-2002 02-09-2003 24-02-2003 24-09-2004 06-01-2004 03-10-2002 13-09-2001
JP 2000165995 A	16-06-2000	JP 3420951 B2 JP 2000165995 A	30-06-2003 16-06-2000
US 2009062656 A1	05-03-2009	CN 101444430 A JP 2009060501 A US 2009062656 A1	03-06-2009 19-03-2009 05-03-2009

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN

(72)発明者 ウィックリン ケヴィン グレイソン

オランダ国 5 6 5 6 アーエー アインドーフエン ハイ テック キャンパス ビルディング
4 4

(72)発明者 ユイ ヨーンジアー

オランダ国 5 6 5 6 アーエー アインドーフエン ハイ テック キャンパス ビルディング
4 4

(72)発明者 ノウルズ ヘザー ベック

オランダ国 5 6 5 6 アーエー アインドーフエン ハイ テック キャンパス ビルディング
4 4

(72)発明者 パオリーノ ジェームズ

オランダ国 5 6 5 6 アーエー アインドーフエン ハイ テック キャンパス ビルディング
4 4

(72)発明者 デヴィットセン リチャード エドワード

オランダ国 5 6 5 6 アーエー アインドーフエン ハイ テック キャンパス ビルディング
4 4

Fターム(参考) 4C601 BB03 GB06 GB20 GB26 GB31 GB45

5D019 AA17 FF04 GG06

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2014512899A5	公开(公告)日	2015-04-16
申请号	JP2013558556	申请日	2012-03-14
[标]申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦电子股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦NV哥德堡		
[标]发明人	スドルヴォイテク ウィックリンケヴィングレイソン ユイヨーンジアーン ノウルズヘザーベック パオリーノジェームズ デヴィットセンリチャードエドワード		
发明人	スドル ヴォイテク ウィックリン ケヴィン グレイソン ユイ ヨーンジアーン ノウルズ ヘザー ベック パオリーノ ジェームズ デヴィットセン リチャード エドワード		
IPC分类号	A61B8/00 H04R17/00		
CPC分类号	A61B8/4494 A61B8/4483 B06B1/0629 G10K11/002		
FI分类号	A61B8/00 H04R17/00.330.J		
F-TERM分类号	4C601/BB03 4C601/GB06 4C601/GB20 4C601/GB26 4C601/GB31 4C601/GB45 5D019/AA17 5D019/FF04 5D019/GG06		
优先权	61/453690 2011-03-17 US		
其他公开文献	JP2014512899A JP5972296B2		

摘要(译)

用于超声探头的超声换能器阵列堆叠的背衬块形成为高导热率材料的复合结构，其中嵌入有声学阻尼材料的结构。在构造的实施例中，复合结构由导热石墨块形成，其中形成有多个圆柱形孔，这些圆柱形孔填充有声学阻尼材料。孔从换能器叠层的后部相对于Z轴方向成角度，使得在该方向上行进的混响能量将遇到声学阻尼材料。孔周围的石墨有效地将热量传导到探头的后部并远离换能器叠层及其ASIC。